Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0411U000606

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 15-03-2011

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Луньов Сергій Валентинович

2. Luniov Sergey Valintinovich

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 24-02-2011

Спеціальність за освітою: 8.040203

Місце роботи здобувача: Луцький національний технічний університет

Код за ЄДРПОУ: 05477296

Місцезнаходження: Україна, Волинська область, місто Луцьк, вул. Львівська, 75, 43018

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 32.051.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Луцький національний технічний університет

Код за ЄДРПОУ: 05477296

Місцезнаходження: Україна, Волинська область, місто Луцьк, вул. Львівська, 75, 43018

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:

1. Тензоефекти в багатодолинних напівпровідниках (n-Ge, n-Si)

2. Tenzoeffects in multivalley semiconductors (n-Ge , n-Si).

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена вивченню особливостей тензоефектів в кристалах n-Ge та n-Si при наявності технологічних і радіаційних дефектів. Запропоновано метод розрахунку зміни положення глибоких енергетичних рівнів при дії одновісної пружної деформації, на основі якого було визначено баричні коефіцієнти зміни енергетичної щілини між глибоким енергетичним рівнем золота і дном зони провідності n-Ge та глибоким енергетичним рівнем А-центру і дном зони провідності n-Si для різних кристалографічних напрямків. Оцінено ступінь заповнення глибоких рівнів в кристалах n-Ge та n-Si. Досліджено особливості міждолинного розсіяння в кристалах кремнію при високих температурах.

2. Dissertation is devoted the study of features of tenzoeffects in crystals n-Ge and n-Si at presence of technological and radiation defects. A method for calculating changes position of deep energy levels under the influence of uniaxial elastic deformation on the basis of which were determined pressure coefficients changes the energy gap between the deep energy level of gold and the bottom of the conduction band n-Ge and a deep energy level of the A-centre and the bottom of the conduction band n-Si for different crystallographic directions is

offered. The degree of filling deep levels in crystals of n-Ge and n-Si is assessed. The features of intervalley scattering in silicon crystals at high temperatures is investigated.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Федосов С.А.
2. Fedosov S.A.

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Баранський П.І.
2. Баранський П.І.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Головацький В.А.
2. Головацький В.А.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Давидюк Георгій Євлампійович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Давидюк Георгій Євлампійович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.